



日本結晶成長学会主催

第1回 結晶成長基礎セミナー

- ◇ 日時： 2017年6月20日（火）10:00～17:50
◇ 場所： 産総研臨海副都心センター別館11階会議室
（東京都江東区青梅2-3-26）
ゆりかもめ「テレコムセンター」駅下車徒歩3分）

「基礎から」「わかりやすく」「すぐ役に立つ」を目標に、結晶成長基礎セミナーを企画します。基礎編として、日本結晶成長学会が得意とする、結晶成長の基礎、核形成制御、結晶成長観察、計算機シミュレーションについて講義し、応用編として窒化物、SiCの結晶成長についての総論を講義します。対象として半導体や鉱物、タンパク質、製薬、化学工業等の研究者・学生を想定し、企業の新人研修等にも利用できるよう工夫をしています。

【プログラム】

10:00-10:05	主催者挨拶	柿本浩一（日本結晶成長学会会長）
＜基礎編＞		
10:05-11:35	結晶成長の基礎（結晶成長の歴史、基礎、核形成）	柿本浩一（九州大学）
13:00-14:00	化学工学（核形成と粒径の制御）	大嶋寛（関西化学機械製作株式会社 ・大阪市立大学名誉教授）
14:00-15:00	結晶成長観察（光学顕微鏡の基礎と最前線）	佐崎元（北海道大学）
15:10-16:10	計算機シミュレーション（計算方法の基礎、成長過程の可視化と解析）	灘浩樹（産総研）
＜応用編＞		
16:10-17:00	GaN、AlN（化学熱力学による気相成長の理解）	熊谷義直（東京農工大学）
17:00-17:50	SiCバルク（溶液成長法最前線）	宇治原徹（名古屋大学）

【参加受付】参加希望の方はメールに氏名、所属、メールアドレスを記入の上、jiro.nishinaga@aist.go.jp（産総研西永）まで申込み下さい。当日受付も行います。

【参加費】当日会場にてお支払ください。（テキスト代込）日本結晶成長学会会員 5,000 円、日本結晶成長学会学生会員 2,500 円、一般 10,000 円、一般学生 5,000 円、日本結晶成長学会賛助会員企業所属の方は、日本結晶成長学会会員扱いとします。当日ご入会の方も日本結晶成長学会会員扱いとします。

【世話人】日本結晶成長学会教育公益委員会
西永慈郎（産業技術総合研究所）、綿打敏司（山梨大学）、鈴木良尚（徳島大学）

【問い合わせ先】
西永慈郎（産総研）Tel: 029-861-5042、E-mail: jiro.nishinaga@aist.go.jp